

3.2 設備仕様

3.2.1 設備寸法

標準仕様

- セミオート仕様 : 幅 1,055 mm × 奥行 1,480 mm × 高さ 1,800 mm
- フルオート仕様 : 幅 1,665 mm × 奥行 1,815 mm × 高さ 1,800 mm

設備質量

- セミオート仕様 : 約 2,000 kg
- フルオート仕様 : 約 3,000 kg

3.2.2 周囲環境

周囲温度

23°C ± 3°C

周囲湿度

65% ± 10% RH 以下 (もしくは、結露なきこと)

クリーン度

クラス 10,000

使用空気圧

0.49 MPa

空気消費量

- セミオート仕様
 - 本体エア-1 : 約 400 l/min (AN.R)
 - 本体エア-2 : 約 400 l/min (AN.R)
 - 本体エア-3 : 約 50 l/min (AN.R)
- フルオート仕様
 - 本体エア-1 : 約 500 l/min (AN.R)
 - 本体エア-2 : 約 400 l/min (AN.R)
 - 本体エア-3 : 約 50 l/min (AN.R)

空気流入口

- 本体エア-1 : R1/4×1...各空圧機器用
- 本体エア-2 : R1/4×1...断熱冷却用
- 本体エア-3 : R1/4×1...ヘッド荷重シリンダ用

=参考=

コンプレッサは水分分離器・油分分離器を設置し、清浄乾燥した圧縮空気を供給してください。

設置床面

- 床面状態 : ± 10 mm
- 許容荷重 : 9800 N/m² 以上

=注意=

付近にノイズ源および振動源がないこと。

3.2.3 基本仕様

対象基板

- 基板サイズ : Min. 50 mm × 50 mm ~ Max. 330 mm × 250 mm
- 装着可能範囲 : Min. 50 mm × 40 mm ~ Max. 310 mm × 240 mm (奥・手前 5 mm 装着不可)
- 基板厚み : Min. 0.5 mm ~ Max. 2.5 mm
- 実装済み部品高さ : 上面 Max. 3 mm
下面 Max. 10 mm
- 基板材質 : セラミック、ガラエポ、ガラス、ポリイミド

対象 IC

- Min. 1 mm × 1 mm ~ 20 mm × 20 mm
- 厚み : 0.1 ~ 0.5 mm

ボンディングステージ

- 基板下面側を吸着保持します。
- 基板の上面を一定高さとするよう、基板の厚みに応じて ± 1.5 mm の範囲でボンディングステージを自動的に上下できます。
- 品種によって基板サイズや吸着保持位置が変わる場合、ボンディングステージブロックを交換して対応します。
- ステージ加熱 : Max. 150°C ± 15°C

実装精度

- ± 3 μm / 3σ (XY 中心値) ※θ精度は IC サイズにより異なります。

=注意=

- 条件 : ヘッド、ステージともに加熱なし。
- 弊社評価用ガラス基板、□6mm IC、同一温度環境 (23°C ± 3°C) にて評価。
- 連続生産する際には、定期的にキャリブレーションを実施して、XY 中心値の変動を抑える必要があります。

ヘッド荷重

- 5 N ~ 490 N ± 5% か ± 0.5 N の大きい方

ヘッド加熱

- 常温 ~ 500°C (セラミックヒーターオプション選択時) ※設備熱電対温度

実装タクト

- フルオート仕様 : 1.8 s / 点
- セミオート仕様 : 3.5 s / 点

=注意=

- ボンディング時間、およびコンタクト・リリース時のスロー上下動作時間は除きます。